

졸업논문청구논문

PDMS stamping 방식으로 만든 CsPbBr₃의 TRPL 분석

The TRPL analysis of CsPbBr₃ made with PDMS
stamping method

김 신 유 (金 信 裕 Kim, Shin You)

17021

과학영재학교 경기과학고등학교

2019

PDMS stamping 방식으로 만든 CsPbBr₃의 TRPL 분석

**The TRPL analysis of CsPbBr₃ made with PDMS
stamping method**

[논문제출 전 체크리스트]

1. 이 논문은 내가 직접 연구하고 작성한 것이다.
2. 인용한 모든 자료(책, 논문, 인터넷자료 등)의 인용표시를 바르게 하였다.
3. 인용한 자료의 표현이나 내용을 왜곡하지 않았다.
4. 정확한 출처제시 없이 다른 사람의 글이나 아이디어를 가져오지 않았다.
5. 논문 작성 중 도표나 데이터를 조작(위조 혹은 변조)하지 않았다.
6. 다른 친구와 같은 내용의 논문을 제출하지 않았다.

The TRPL analysis of CsPbBr₃ made with PDMS stamping method

Advisor : Teacher Park, Kie Hyun

by

17021 Kim, Shin You

Gyeonggi Science High School for the gifted

A thesis submitted to the Gyeonggi Science High School in partial fulfillment of the requirements for the graduation. The study was conducted in accordance with Code of Research Ethics.*

2018. 7. 21.

Approved by
Teacher Park, Kie Hyun
[Thesis Advisor]

*Declaration of Ethical Conduct in Research: I, as a graduate student of GSHS, hereby declare that I have not committed any acts that may damage the credibility of my research. These include, but are not limited to: falsification, thesis written by someone else, distortion of research findings or plagiarism. I affirm that my thesis contains honest conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis advisor.

PDMS stamping 방식으로 만든 CsPbBr₃의 TRPL 분석

김 신 유

위 논문은 과학영재학교 경기과학고등학교 졸업논문으로
졸업논문심사위원회에서 심사 통과하였음.

2018년 7월 21일

심사위원장 김 제 흥 (인)

심사위원 정 문 석 (인)

심사위원 박 기 현 (인)

The TRPL analysis of CsPbBr₃ made with PDMS stamping method

Abstract

Perovskite is being spotlighted because of its high carrier mobility and cheap price. Also, many new method of making perovskite is being developed rapidly. The aim of this study is to check the capability of PDMS stamping method on making perovskite. CsPbBr₃ solution was spin-coated on the silicon wafer, and was stamped with PDMS to create CsPbBr₃ single crystal. The crystal structure was checked by XRD measurement, and its carrier mobility was checked by TRPL measurements. TRPL measurements showed a consistent ratio between exciton recombination rate and biexciton recombination rate. It ensured that PDMS stamping method was capable of making perovskites. Furthermore, the variation of TRPL data indicates that there is a possibility of calculating the purity quantitatively of the crystal from TRPL datas.

PDMS stamping 방식으로 만든 CsPbBr₃의 TRPL 분석

초 록

페로브스카이트는 전하 수송 능력이 좋고 제조하기 쉽고 값싸다는 데에 장점을 두며 많은 광학 소자에서 응용되고 있다. 특히 이 물질은 태양전지에서 태양에너지를 이용해서 전하를 수송하는 역할로 쓰인다. 본 연구에서는 대표적인 페로브스카이트인 CsPbBr₃ 단 결정을 비교적 최근에 발견된 방법인 PDMS-stamping 방법으로 만들고, 만들어진 결정이 CsPbBr₃의 특성을 지니는지 확인한다. X-Ray diffraction (XRD) 을 통해 결정의 구조를 확인하고, Time-Resolved Photoluminescence (TRPL) 분석을 통해 결정의 carrier dynamics를 확인할 수 있다. 이를 기존의 박막 형태의 CsPbBr₃의 데이터와 이를 비교하였다. 이를 통해 PDMS-stamping 방식이 페로브스카이트를 만드는데 쓰일 수 있다는 것을 보일 수 있으며, 더 나아가 결정의 내부와 외부에서의 TRPL 데이터의 변화를 통해 결정의 순도에 대한 정성적인 예측을 할 수 있다.

Key words: TRPL, CsPbBr₃ single crystal, carrier lifetime

Contents

Abstract	i
Contents	iii
I 서론	1
II 실험 과정	4
II.1 준비	4
II.2 분석	4
III Results	5
III.1 Optic Microscopy	5
III.2 X-Ray Diffraction	5
III.3 TRPL spectroscopy	6
IV Conclusion	9

I. 서론

페로브스카이트는 태양 전지에서 빛을 흡수해서 움직이는 전하를 만드는 역할을 한다. 태양 전지가 1970년대 재생 가능 에너지의 일부로써 주목을 받은 이후 지속적인 투자를 받아왔으며 2030년이 되기 전에 광전지로 만드는 전기의 양이 전체 전력의 3분의 1이나 될 것이라는 예측도 있다 [?]. 페로브스카이트 재료(이 논문에서 페로브스카이트라고 한다)

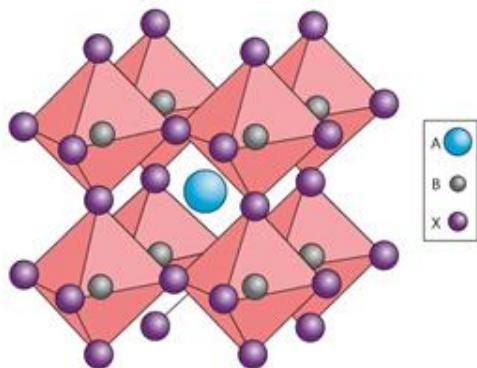


Figure 1. The structure of standard perovskite [?]. The octahedral structure on the corner can be seen, made with X.

는 ABX_3 의 결정 구조를 가진 물질로, 여기서 A, B는 양이온, X는 음이온이다. 쇼클리-퀴서 한계(Shockley-Quiesser limit) 이론에 의하면, 하나의 p-n 접합에서 1.34eV의 전위차가 걸릴 때 가장 큰 효율인 33.7 %가 발생한다고 한다 [?]. 여기서 페로브스카이트의 장점이 대두되는데, A, B, X의 각 구성요소는 상당히 자유롭게 교체할 수 있기 때문에 밴드 간극이 넓은 다양한 페로브스카이트가 만들어질 수 있다. 즉, 전위차를 잘 조절하면 최대 효율을 도달하는 페로브스카이트를 만들 수 있다는 의미이다. 또한, 페로브스카이트는 꼭짓점을 공유하는 팔면체 구조를 가지고 있기 때문에 전하 유동성이 뛰어나다 [?]. 이 특성은 페로브스카이트가 빛을 잘 흡수하고 긴 양공 확산 길이를 가질 수 있게 한다?. 마지막으로, 페로브스카이트 태양전지는 전통적인 실리콘 태양전지에 비해 쉽게 만들어진다. 페로브스

카이트 재료는 100°C 이하로 합성할 수 있는 반면 실리콘 태양전지는 불순물을 제거하기 위해 900°C 이상의 온도가 필요하다. 많은 연구자들과 과학자들은 이러한 장점을 가진 페로브스카이트의 제작 비용, 시간을 줄이고 에너지 전환 효율성을 높이기 위해 활발히 연구하고 있다. 처음으로 페로브 스카이트를 이용하여 빛을 이용한 발전을 한 사람은 Miyasaka였다. 그는 2006년에 처음으로 $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbBr}_3$ 를 이용한 전지로 2.2최근에는 PDMS(폴리디메틸실록산)를 이용해 단결정 할라이드(hallide) 페로브스카이트를 만드는 새로운 방법이 발견되었다. PDMS는 용액이 웨이퍼에 코팅된 후 압력으로 이를 누르는 데 사용된다. PDMS 스템핑 없이 AFM(Atomic force microscopy)으로 측정한 거칠기는 $79.1 \pm 43.3\text{nm}$ 이었지만 PDMS 스템핑은 거칠기를 $7.1 \pm 4.6\text{nm}$ 로 감소시켰다 [?]. 또한, 이 방법은 용액에서 석출하는 방법 (Czochralski 방법) 같은 기존의 방법보다 많은 시간을 절약했다. PDMS 스템프를 적용한 연구에서, 할로겐화 페로브스카이트 필름에 약 130nm 크기의 패턴을 성공적으로 인쇄했다 [?]. 이러한 패턴은 1차원 및 2차원 분산 피드백(DBF) 구조에서 표면 반사율을 감소시켜 효율성을 향상시키기 위해 사용될 수 있다. 앞선 논문들에서는 PDMS 스템핑 방식으로 페로브스카이트를 만들긴 했지만 이에 대한 의문을 제기하진 않았다. 새롭게 발견된 방법으로 만들어진 페로브스카이트가 기존의 방법으로 만들어진 페로브스카이트와 같은 특성을 가지고 있다는 것을 증명해야 한다. 이 논문에서는 이를 증명하기 위해 XRD 무늬와 TRPL 분석을 이용하였다. XRD(X-Ray Diffraction)은 결정성 물질에 X선을 쏘아 나타나는 고유 무늬로 물질을 구분하는 것이다. 측정기의 각도를 바꿔가며 도달하는 X선의 세기를 측정하여 무늬를 알아낸다. TRPL(Time-Resolved Photoluminescence)은 전하 운반자의 시간에 따른 변화를 관찰할 수 있는 장치이다. PL(Photoluminescence)은 물질에 에너지를 가해서 들뜬 상태를 만든 후 물질에서 방출되는 빛을 파장별로 검출하는 방식이다. TRPL은 PL spectra의 시간에 따른 변화를 확인하는 방식으로, 광발광 수명(photoluminescent lifetime)으로 물질을 식별하거나 LED의 효율을 측정되는 데에 쓰인다. 물질마다 TRPL 데이터의 모양이 다른데, 이는 광발광 수명이 물질의 특성이기 때문이다. CsPbBr_3 의 경우에는 PL의 시간에

따른 변화가 exciton과 biexciton의 재결합에 의해 일어나는데, 각각의 수명은 1170 ± 10 ps와 510 ± 5 ps이다 [?]. 이렇게 본 논문은 XRD와 TRPL 분석 방법을 이용하여 PDMS 스텁핑을 이용한 새로운 방법이 페로브스카이트를 합성할 수 있다는 것을 제시한다.

II. 실험 과정

II.1 준비

CsPbBr_3 용액은 실온 1기압 상태에서 제작되었다. CsPbBr_3 의 용액을 만들기 위해서 CsBr 과 PbBr_2 를 1:1의 몰 비율로 CsBr 0.638g과 PbBr_2 1.101g을 섞었으며 용매인 Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 6ml에 섞었다. 용매와 용질을 균일하게 섞기 위해서 50ml들이 통에 담은 후 뚜껑 부분을 파라필름으로 밀봉하고, 통을 물이 담긴 비커에 담은 후 초음파를 이용한 Sonication을 3분간 진행하였다. 또, Sonication으로 세척한 Silicon wafer 위에 O2 plasma



Figure 2. Pictures show the sonication process, spin-coating process, and PDMS stamping process, respectively.

를 이용하여 코팅한 후 3000rpm으로 40초간 spin coating을 이용하여 용액을 균일하게 펴쳐주었다. 마지막으로 미리 100도로 달궈놓았던 핫플레이트에서 5분간 PDMS를 이용하여 눌러주었다. PDMS위에 200g의 무게를 올려놓아 stamping이 잘 일어나도록 하였다.

II.2 분석

CsPbBr_3 결정이 만들어졌는지 광학현미경으로 확인한 후, X선 회절법과 TRPL 분석을 진행하였다. XRD measurement는 BRUKER사의 SmartLab 모델을 이용하였고, 입사각을 10° 에서 70° 까지 변화시키면서 측정하였다. 또, PL과 TRPL은 NT-MDT II Ntegra Spectra DUO Max라는 모델을 이용하여 측정을 하였다. 각각 ND0, ND1 필터를 이용해서 측정하였다.

III. Results

III.1 Optic Microscopy

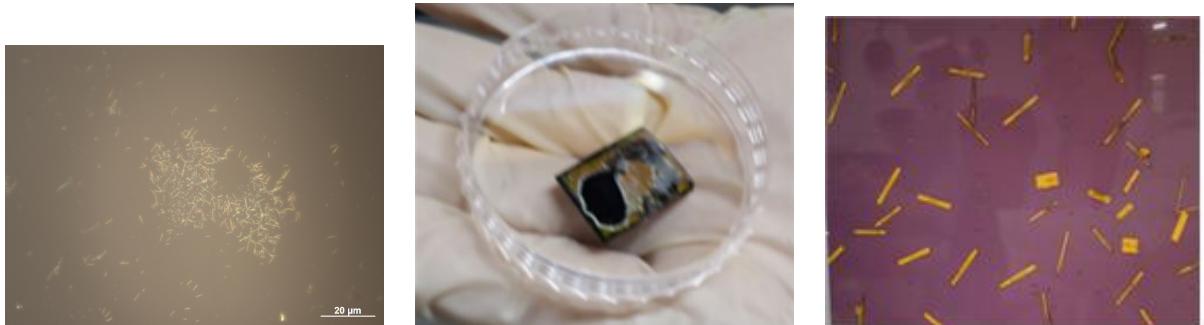


Figure 3. The first picture shows the silicon wafer with no crystals. After the crystal successfully grew, it could be seen by the eyes(middle) and by optic microscopy(right)

III.2 X-Ray Diffraction

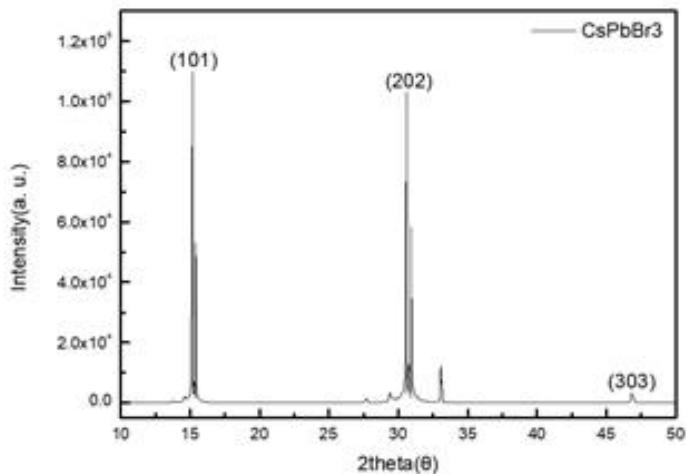


Figure 4. The angle of incidence was varied 10 to 70 degrees. The graph was drawn with Origin 8.0

CsPbBr_3 의 XRD peak는 $2\theta = 14.919, 30.099, 47.957$ 도에서 발견되는 기존의 데이터와

일치하기 때문에 XRD 분석을 통해 CsPbBr_3 결정이 만들어졌다는 것을 알 수 있다 [?].

III.3 TRPL spectroscopy

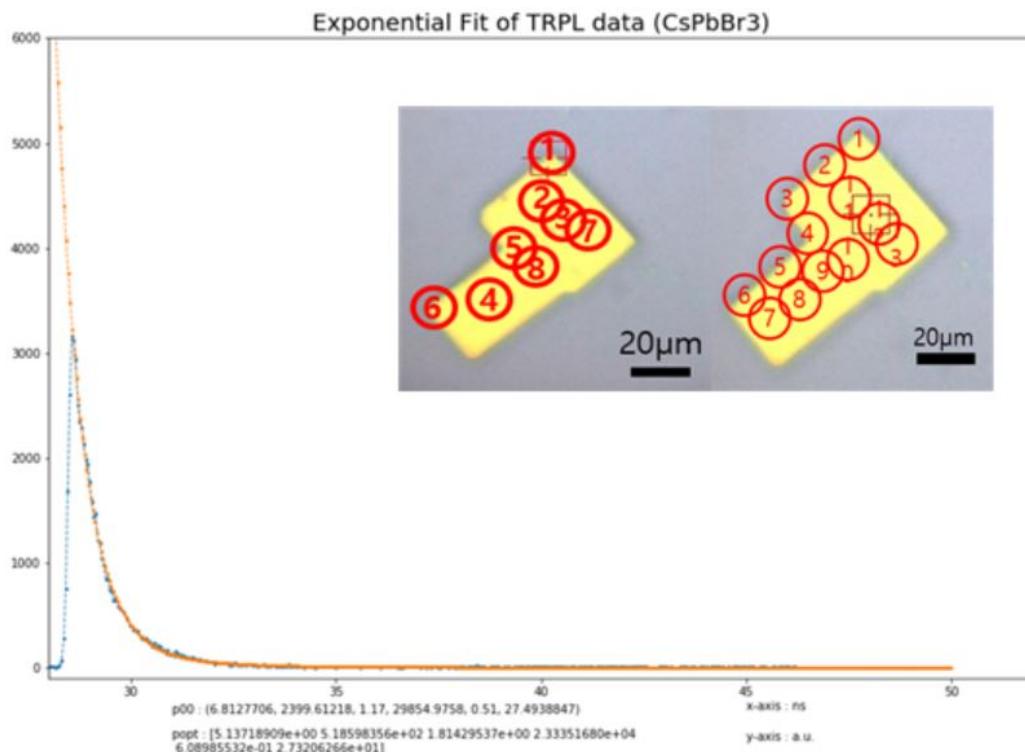


Figure 5. TRPL graph was fitted with sum of exponential functions.x axis is time(ns) y axis is the intensity of signal(a.u.). Two pictures at the right top shows the point where the TRPL datas were collected. Left picture corresponds to ND0 filter, and the right picture corresponds to ND1 filter.

TRPL 그래프는 위의 그림과 같이 파란색의 그래프이다. $t=28\text{ns}$ 부근에서 최댓값을 확인할 수 있었고, 그 시간 이후의 데이터를 시간에 따른 지수 함수(exponential function)들의 합으로 fitting 할 수 있는데, 그 식은 $\sum_i e^{-t/\tau_i}$ 로 표현된다. CsPbBr_3 는 exciton과 biexciton의 recombination으로 나뉘기 때문에 두 개의 exponential function의 합으로 표현하였다.

그래프의 피팅을 위해 파이썬을 활용하였다. TRPL 데이터를 순서쌍으로 바꿔서 그래프를 그린 후, 파이썬에 내재된 함수인 curve fit을 이용하여 최소제곱법으로 가장 비슷한

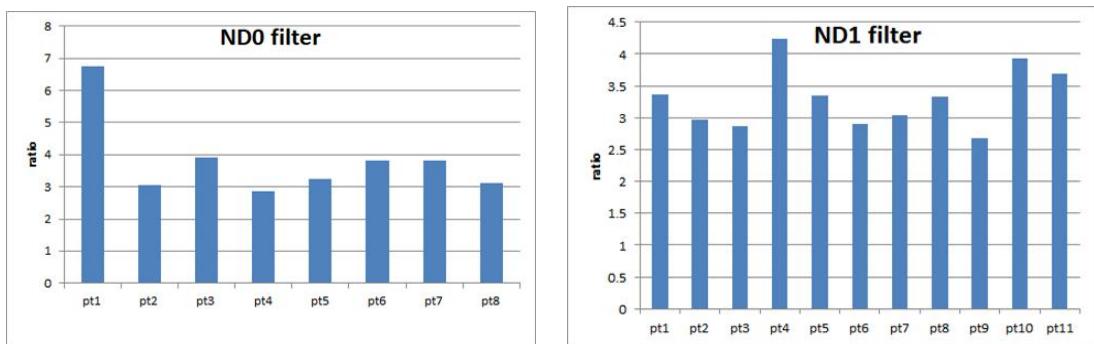


Figure 6. The histogram shows the ratio between exciton recombination rate and biexcitonrate, differed by the point of laser. Left picture is when ND0 filter is used, and the right picture is when ND1 filter is used. The standard deviation of ratio is 0.432 and 0.483, respectively.

함수를 찾아낸다. 만들어진 결정이 CsPbBr_3 임을 확인하기 위해서 exciton과 biexciton의 recombination rate에 대한 비율을 계산하였다. ND0 필터를 사용했을 때 두 recombination rate 사이의 비율에 대한 평균값은 3.43 이었고 ND1필터를 사용 했을 때는 3.30이었다.

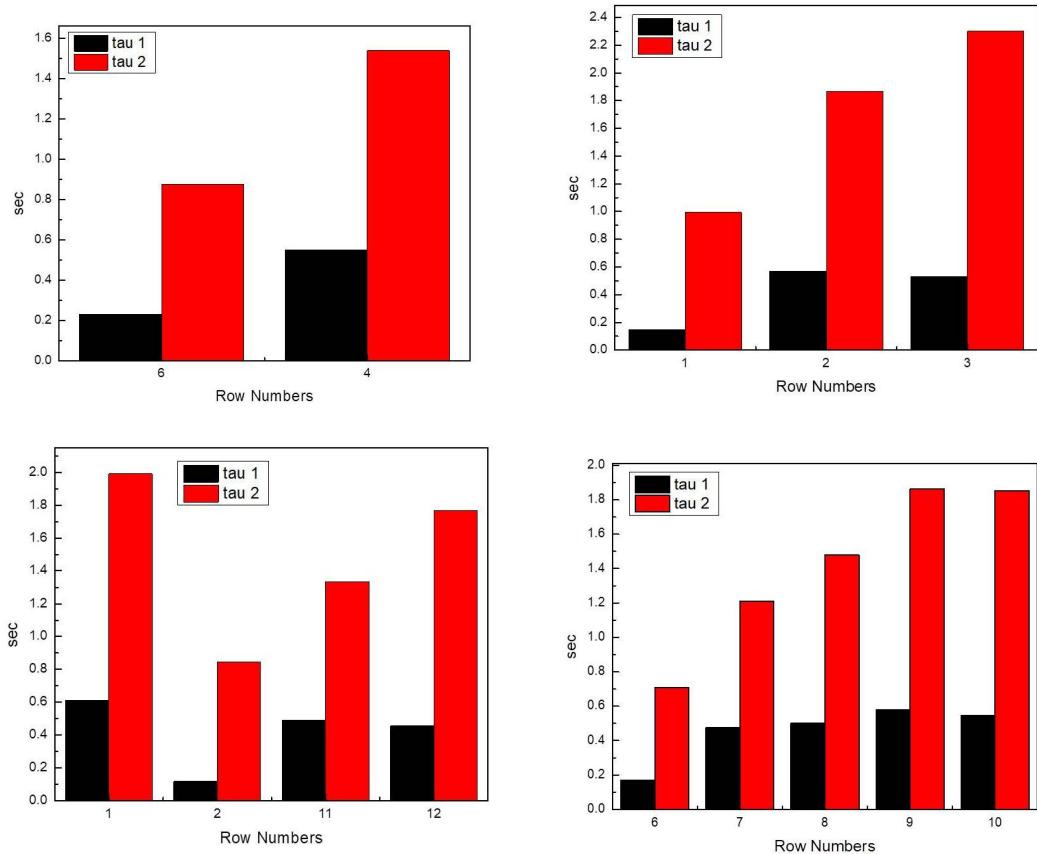


Figure 7. Both exciton / biexciton recombination rate increased when the laser point headed to the center of the crystal. The unit of y-axis is ns.

Figure 7과 8은 exciton / biexciton recombination rate의 비율이 아닌, 값 자체를 히스토그램으로 나타낸 것으로, 두 값 모두가 결정의 중심쪽으로 갈수록 증가하고 있음을 관찰할 수 있다.

IV. Conclusion

본 연구의 결과는 다음과 같다:

1. Exciton recombination rate와 biexciton recombination rate 사이의 비율의 평균은 3.43 와 3.30이었다. 이론적으로 알려진 2.29이라는 비율 [?] 과는 다소 상이하였으나 두 속도 사이의 비율이 결정의 위치가 바뀌어도 일정한 것으로 보아 만들어진 결정이 동일한 특성을 지닌 물질이라는 것을 확인 할 수 있었다. 두 값이 약간의 차이를 갖는 이유는 2.29라는 값은 CsPbBr_3 박막의 값이지만 3.30나 3.43라는 값은 CsPbBr_3 단결정의 값이기 때문이라고 예상된다.
2. 결정의 중심부로 갈수록 커지는 exciton / biexciton recombination rate으로부터 결정의 중심부의 결정의 순도가 더 높다는 것을 알 수 있다. recombination rate가 커진다는 것은 원자가띠에 인접한 defect의 에너지띠보다 전도띠에서 더 많은 recombiantion이 일어났다는 의미이다. 그렇기 때문에 recombination rate가 증가하면, defect가 적다는 의미이고, 순도가 높다는 의미이기도 하다.

결국 PDMS-stamping 방법으로 만든 CsPbBr_3 단결정이 기존의 CsPbBr_3 와 동일하다는 것을 보일 수 있었다. 또, 결과 2번 항목에서 결정의 순도의 비교는 오직 정성적으로 이루어졌다. 만약 recombination rate와 결정의 순도 간의 정량적인 관계를 구할 수 있다면 결정의 순도를 유추할 수 있는 획기적인 방법이 될 것이다.